

(iv) piezoelectric polymers and copolymers that are made from vinylidene fluoride, in sheet or film form, and that have a thickness greater than 200 μm .

Silicone Fluids and Greases

1755 Silicone fluids and greases, as follows:

(a) fluorinated silicone fluids, other than those with a kinematic viscosity of 5 000 mm^2/s or higher, measured at 25°C; and

(b) silicone and fluorinated silicone lubricating greases that are capable of operating at temperatures of 180°C or higher and that have a drop point of 220°C or higher, where the method of test is ASTM D566 or IP 132/65, *Standard Test Method for Dropping Point of Lubricating Grease*.

Crystalline Compounds and Materials

1757 Crystalline compounds and materials, as follows:

(a) monocrystalline silicon, other than metallurgical-grade monocrystalline silicon that has a purity of not greater than 99.97 per cent;

(b) gallium that has a purity of equal to or greater than 99.9999 per cent and gallium III-V compounds of any purity level, other than

(i) gallium phosphide, and

(ii) other gallium III-V compounds that have a dislocation density, that is, etch-pit density, of greater than 5 000 per mm^2 ;

(c) indium of a purity greater than 99.9995 per cent and III-V indium compounds that contain more than 1 per cent indium;

(d) hetero-epitaxial materials that consist of a monocrystalline insulating substrate epitaxially layered with silicon, compounds of gallium or compounds of indium;

(e) elemental cadmium and tellurium of a purity equal to or greater than 99.9995 per cent and cadmium-telluride compounds of a purity equal to or greater than 99.99 per cent, or single crystals of cadmium-telluride of any purity level;

(f) polycrystalline silicon, other than polycrystalline silicon that has a purity of not greater than 99.99 per cent and that contains at least 0.5 part in 10^6 each of iron, carbon, boron and phosphorus, in addition to other impurities;

(g) compounds that are used in the synthesis of the materials included in paragraph (f), or that are used as the silicon source in the deposition of epitaxial layers of silicon, silicon oxide or silicon nitride, and that have a purity level based on the amount of the primary constituent of 99.5 per cent or greater or, in the case of dichlorosilane, that have a purity of dichlorosilane of 97 per cent or greater;

(h) single crystal sapphire substrates;

(i) boric oxide, in powder or cast form, that has a purity of 99.9 per cent or greater and contains 1,000 ppm of water or less;

(j) monocrystalline germanium that has a resistivity of greater than 1 000 $\text{ohm}\cdot\text{mm}$;

(k) resist materials, as follows:

(i) negative resists the spectral response of which has been adjusted for use below 350 μm ,

(ii) positive resists,

(iii) resists that are for use with E-beams or ion beams and have a sensitivity of 1 $\mu\text{C}/\text{mm}^2$ or better,

(iv) polymères et copolymères piézoélectriques constitués de fluorure de vinylidène se présentant sous forme de film ou de feuille, et ayant une épaisseur de plus de 200 μm .

Fluides et graisses silicones

1755 Fluides et graisses silicones, à savoir:

a) fluides silicones fluorés, à l'exclusion de ceux présentant une viscosité cinématique d'au moins 5 000 mm^2/s , mesurée à 25 °C;

b) graisses lubrifiantes silicones et silicones fluorées pouvant agir à des températures d'au moins 180 °C et ayant un point de liquéfaction d'au moins 220 °C, selon les essais effectués d'après les méthodes ASTM D566 ou IP 132/65 intitulées *Standard Test Method for Dropping Point of Lubricating Grease*.

Composés et matériaux cristallins

1757 Composés et matériaux cristallins, à savoir:

a) silicium monocristallin, à l'exclusion du silicium monocristallin de qualité métallurgique ayant une pureté d'au plus 99,97 pour cent;

b) gallium d'une pureté d'au moins 99,9999 pour cent et composés III/V du gallium, à l'exclusion:

(i) du phosphore de gallium,

(ii) d'autres composés III/V du gallium ayant une densité de dislocation, c'est-à-dire densité des figures d'attaque, de plus de 5 000 par mm^2 ;

c) indium d'une pureté de plus de 99,9995 pour cent et composés III/V d'indium contenant plus de 1 pour cent d'indium;

d) matériaux hétéro-épitaxiés consistant en un substrat monocristallin isolant à couches épitaxiales de silicium, de composés de gallium ou de composés d'indium;

e) cadmium et tellure élémentaires d'une pureté d'au moins 99,9995 pour cent et composés de cadmium-tellure d'une pureté d'au moins 99,99 pour cent ou monocristaux de cadmium-tellure quelle que soit leur pureté;

f) silicium polycristallin, à l'exclusion du silicium polycristallin ayant une pureté d'au plus 99,99 pour cent et contenant au moins 0,5 millionième de fer, de carbone, de bore et de phosphore, plus d'autres impuretés;

g) composés utilisés pour la synthèse des produits inclus dans l'alinéa f) ou utilisés comme source de silicium dans le dépôt de couches épitaxiales de silicium, d'oxyde de silicium ou de nitrure de silicium, ayant une pureté fondée sur la quantité du constituant principal d'au moins 99,5 pour cent ou dans le cas du dichlorosilane, ce dernier ayant une pureté d'au moins 97 pour cent;

h) substrats de saphir monocristallin;

i) oxyde de bore, sous forme de poudre ou de moulages, d'une pureté d'au moins 99,9 pour cent contenant au plus 1 000 millionièmes d'eau;

j) germanium monocristallin d'une résistivité de plus de 1 000 $\text{ohm}\cdot\text{mm}$;

k) matières de protection qui sont, selon le cas:

(i) négatives et dont la réponse spectrale a été réglée pour qu'elles puissent être utilisées à une longueur d'onde de moins de 350 μm ,

(ii) positives,

(iii) sensibles aux faisceaux électroniques ou ioniques, ayant une sensibilité égale à 1 $\mu\text{C}/\text{mm}^2$ ou plus fine que cette valeur,